

## 低電圧ボルテージディテクタ

## R3111xxxxA/C シリーズ

NO. JA-071-0305

#### ■ 概要

R3111x シリーズは、CMOS プロセス技術を用いて開発した、低電圧動作仕様の高精度、超低消費電流の電圧検出器です。システムリセット等に用いられる IC で、内部回路は基準電圧源、コンパレータ、検出電圧用抵抗網、ヒステリシス回路及び出力ドライブトランジスタから構成されています。又、検出電圧は高精度にIC 内で固定されている完全無調整型となっています。

出力形態は、Nch オープンドレイン、CMOS の 2 タイプがあります。

電気的特性につきましては弊社従来製品である Rx5VL シリーズより低電圧動作を狙い電池一本駆動を可能にしました。

パッケージは TO-92, SOT-89, SOT-23-3, SOT-23-5, SC-82AB の 5 種類が有ります。

### ■ 特長

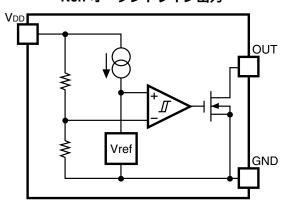
- 超低消費電流......TYP. 0.8µA (VDD=1.5V)
- **動作電圧範囲が広い**.....0.7V ~ 10.0V (Topt=25°C)
- 検出電圧は 0.9V ~ 6.0V 間を 0.1V ステップで設定可能
- 検出電圧精度が高い.....±2.0%
- 検出電圧の温度特性.....TYP. ±100ppm/°C
- 出力形態......Nch オープンドレイン、CMOS の 2 種
- 4種類のパッケージ...... TO-92, SOT-89, SOT-23-3, SOT-23-5, SC-82AB

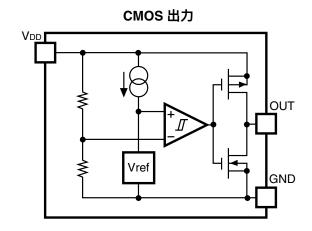
### ■ アプリケーション

- マイコン、ロジック回路のリセット
- バッテリーチェッカー
- レベル弁別装置
- 波形整流回路
- バックアップ電源の切り替え回路
- 停電検出

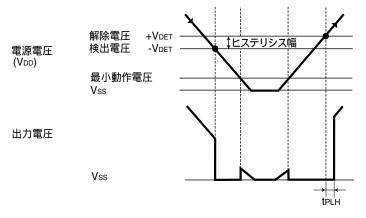
## ■ ブロック図

Nch オープンドレイン出力





### ■ タイムチャート

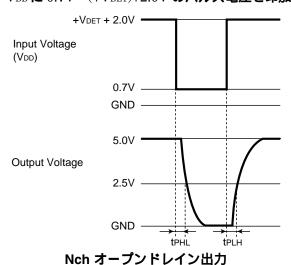


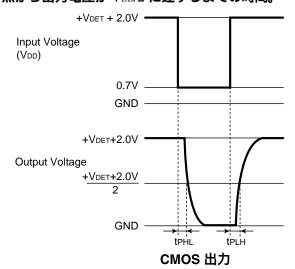
### ■ 伝達遅延 tPLH の説明

伝達遅延 tPLH は以下の条件で規定します。

- Nch オープンドレイン出力の場合 出力端子(OUT)を抵抗 470kΩで 5V にプルアップし、VDD に 0.7V (+VDET)+2.0V のパルス電圧を印加した時点から出力電圧が 2.5V に達するまでの時間。
- 2. CMOS 出力の場合

 $m V_{DD}$  に 0.7V  $(+V_{DET})+2.0V$  のパルス電圧を印加した時点から出力電圧が  $V_{DD}/2$  に達するまでの時間。





## ■ セレクションガイド

R3111x シリーズは検出電圧、出力ドライバの形態、テーピングを用途によって選択指定することができます。 選択指定の方法はデバイスの型式ナンバーを用いて下記のようにおこないます。

R3111x<u>xx</u>xx-xx 型式ナンバー

 $\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$ a b c d e

記号	内容
	パッケージの選択指定に用います。
a	E: TO-92 Q: SC-82AB
	H:SOT-89 N:SOT-23-5/SOT-23-3
1	検出電圧(-VDET)の指定に用います。
b	-VDET <b>の指定は</b> 0.9V ~ 6.0V <b>の範囲内で</b> 0.1V <b>単位にて指定可能。</b>
	パッケージの選択指定に用います。
c	1:SOT-23-3 以外 2:SOT-23-3
	出力形態の選択指定に用います。
d	A: Nch オープンドレイン
	C: CMOS
	テーピングの選択指定に用います。
	テーピングの方向は TO-92 では TZ、SOT-89 では T1、SOT-23-3, SOT-23-5, SC-82AB
e	では TR です。
	TO-92 <b>の袋詰めは</b> C となります (テーピング仕様参照)。

## ■ 端子接続図

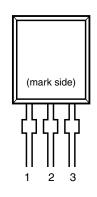
• TO-92

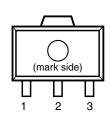
SOT-89

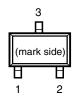
SOT-23-3

SOT-23-5

SC-82AB











## ■ 端子説明

• TO-92

端子番号	端子名
1	$V_{ m DD}$
2	GND
3	OUT

端子番号	端子名
1	OUT
2	$V_{ m DD}$
3	GND

• SOT-23-3

端子番号	端子名
1	OUT
2	GND
3	$ m V_{DD}$

• SOT-23-5

端子番号	端子名
1	OUT
2	$V_{ m DD}$
3	GND
4	NC
5	NC

SC-82AB

端子番号	端子名
1	OUT
2	$V_{ m DD}$
3	NC
4	GND

## ■ 絶対最大定格

-1047 47 — 114			
記号	項目	定格	単位
$ m V_{DD}$	電源電圧	12	V
$ m V_{OUT1}$	出力電圧(CMOS)	Vss-0.3~Vdd+0.3	V
$ m V_{OUT2}$	出力電圧 (Nch)	Vss-0.3~12	V
${f I}_{ m OUT}$	出力電流	70	mA
$\mathbf{P}_{\mathrm{D}}$	<b>許容損失</b> 1 *1	300	mW
PD	<b>許容損失</b> 2 *2	150	mW
Topt	動作周囲温度	-40~85	°C
Tstg	保存周囲温度	-55~125	°C
Tsolder	ハンダ付け条件	260°C	10 秒間

<sup>\*1)</sup> **許容損失**1はSOT-89, TO-92 に適用

<sup>\*2)</sup> **許容損失** 2 は SOT-23-3 , SOT-23-5 , SC-82AB **に適用** 

# ■ 電気的特性

### • R3111x09xA/C

Topt=25°C

記号	項目	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
-V <sub>DET</sub>	検出電圧		0.882	0.900	0.918	V
$V_{ m HYS}$	ヒステリシス幅		0.027	0.045	0.063	V
Iss	消費電流	V <sub>DD</sub> =0.80V 2.90V		0.8 0.9	2.4 2.7	μΑ
$V_{ m DDH}$	最大動作電圧				10	V
	最小動作電圧	Topt=25°C		0.55	0.70	
$V_{ m DDL}$	*注1	-40°C Topt 85°C		0.65	0.80	V
Іоит	出力電流	Nch VDS=0.05V,VDD=0.70V VDS=0.50V,VDD=0.85V	0.01 0.05	0.05 0.50		mA
	(ドライバ出力端子)	Pch VDS=-2.1V,VDD=4.5V	1.0	2.0		mA
$\mathbf{t}_{ ext{PLH}}$	伝達遅延時間 *注2				100	μs
$\Delta$ -V <sub>DET</sub> / $\Delta$ T	検出電圧温度係数	-40°C Topt 85°C		±100		ppm/°C

### R3111x18xA/C

 $Topt{=}25^{\circ}C$ 

記号	項目	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
-V <sub>DET</sub>	検出電圧		1.764	1.800	1.836	V
$ m V_{HYS}$	ヒステリシス幅		0.054	0.090	0.126	V
Iss	消費電流	V <sub>DD</sub> =1.70V 3.80V		0.8 1.0	2.4 3.0	μΑ
$V_{ m DDH}$	最大動作電圧				10	V
	最小動作電圧	Topt=25°C		0.55	0.70	
$ m V_{DDL}$	<b>*注</b> 1	-40°C Topt 85°C		0.65	0.80	V
Іоит	出力電流	Nch VDS=0.05V,VDD=0.70V VDS=0.50V,VDD=0.85V	0.01 1.00	0.05 2.00		mA
	(ドライバ出力端子)	Pch VDS=-2.1V,VDD=4.5V	1.0	2.0		mA
${f t}_{ m PLH}$	伝達遅延時間 *注2				100	μs
$\Delta$ -Vdet/ $\Delta$ T	検出電圧温度係数	-40°C Topt 85°C		±100		ppm/°C

### • R3111x27xA/C

 $Topt=25^{\circ}C$ 

記号	項目	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
-V <sub>DET</sub>	検出電圧		2.646	2.700	2.754	V
$V_{ m HYS}$	ヒステリシス幅		0.081	0.135	0.189	V
Iss	消費電流	Vdd=2.60V 4.70V		0.9 1.1	2.7 3.3	μΑ
$V_{ m DDH}$	最大動作電圧				10	V
	最小動作電圧	Topt=25°C		0.55	0.70	
$V_{ m DDL}$	<b>*注</b> 1	-40°C Topt 85°C		0.65	0.80	V
Іоит	出力電流	Nch VDS=0.05V,VDD=0.70V VDS=0.50V,VDD=1.50V	0.01 1.00	0.05 2.00		mA
	(ドライバ出力端子)	Pch Vds=-2.1V,Vdd=4.5V	1.0	2.0		mA
$\mathbf{t}_{ ext{PLH}}$	伝達遅延時間 *注2				100	μs
$\Delta$ -V <sub>DET</sub> / $\Delta$ T	検出電圧温度係数	-40°C Topt 85°C		±100		ppm/°C

### • R3111x36xA/C

 $Topt=25^{\circ}C$ 

記号	項目	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
-V <sub>DET</sub>	検出電圧		3.528	3.600	3.672	V
V <sub>HYS</sub>	ヒステリシス幅		0.108	0.180	0.252	V
Iss	消費電流	Vdd=3.47V 5.60V		1.0 1.2	3.0 3.6	μΑ
$V_{ m DDH}$	最大動作電圧				10	V
***	最小動作電圧	Topt=25°C		0.55	0.70	7.7
$V_{ m DDL}$	<b>*注</b> 1	-40°C Topt 85°C		0.65	0.80	V
Іоит	出力電流	Nch VDS=0.05V,VDD=0.70V VDS=0.50V,VDD=1.50V	0.01 1.00	0.05 2.00		mA
	(ドライバ出力端子)	Pch VDS=-2.1V,VDD=4.5V	1.0	2.0		mA
${f t}_{ m PLH}$	伝達遅延時間 *注2				100	μs
$\Delta$ -V <sub>DET</sub> / $\Delta$ T	検出電圧温度係数	-40°C Topt 85°C		±100		ppm/°C

● **R3111x45xA/C** Topt=25°C

						1	
記号	項目	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	
-V <sub>DET</sub>	検出電圧		4.410	4.500	4.590	V	
$V_{ m HYS}$	ヒステリシス幅		0.135	0.225	0.315	V	
Iss	消費電流	Vdd=4.34V 6.50V		1.1 1.3	3.3 3.9	μΑ	
$V_{ m DDH}$	最大動作電圧				10	V	
$ m V_{DDL}$	最小動作電圧	Topt=25°C		0.55	0.70	***	
	<b>*注</b> 1	-40°C Topt 85°C		0.65	0.80	V	
Іоит	出力電流 (ドライバ出力端子)	Nch V <sub>DS</sub> =0.05V,V <sub>DD</sub> =0.70V V <sub>DS</sub> =0.50V,V <sub>DD</sub> =1.50V	0.01 1.00	0.05 2.00		mA	
		Pch VDS=-2.1V,VDD=8.0V	1.5	3.0		mA	
$\mathbf{t}_{ ext{PLH}}$	伝達遅延時間 *注2				100	$\mu s$	
$\Delta$ -Vdet/ $\Delta$ T	検出電圧温度係数	-40°C Topt 85°C		±100		ppm/°C	

• R3111x54xA/C Topt=25°C

記号	項目	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	
- $\mathbf{V}_{\mathrm{DET}}$	検出電圧		5.292	5.400	5.508	V	
$ m V_{HYS}$	ヒステリシス幅		0.162	0.270	0.378	V	
$\mathbf{I}$ ss	消費電流	Vdd=5.20V 7.40V		1.2 1.4	3.6 4.2	μΑ	
$ m V_{DDH}$	最大動作電圧				10	V	
**	最小動作電圧	Topt=25°C		0.55	0.70	V	
$ m V_{DDL}$	<b>*注</b> 1	-40°C Topt 85°C		0.65	0.80		
Іоит	出力電流	Nch V <sub>DS</sub> =0.05V,V <sub>DD</sub> =0.70V V <sub>DS</sub> =0.50V,V <sub>DD</sub> =1.50V	0.01 1.00	0.05 2.00		mA	
	(ドライバ出力端子)	Pch VDS=-2.1V,VDD=8.0V	1.5	3.0		mA	
${f t}_{ m PLH}$	伝達遅延時間 *注2				100	μs	
$\Delta$ -V <sub>DET</sub> / $\Delta$ T	検出電圧温度係数	-40°C Topt 85°C		±100		ppm/°C	

\*注 1: 出力電圧が 0.1V 以下になる電源電圧の値。(Nch オープンドレイン品の場合、プルアップ抵抗  $470k\Omega$ 、プルアップ電圧 5.0V とします。)

\*注 2: (CMOS 品の場合) V<sub>DD</sub> に 0.7V→(+V<sub>DET</sub>)+2.0V のパルス電圧を印加した時点から、出力電圧が V<sub>DD</sub>/2 の電位に達するまでの時間。(Nch オープンドレイン品の場合) プルアップ抵抗 470kΩ、プルアップ電圧 5.0V の条件で、V<sub>DD</sub> に 0.7V→(+V<sub>DET</sub>)+2.0V のパルス電圧を印加した時点から、出力電圧が 2.5V に達するまでの時間。

## ■ 検出電圧別電気的特性

#### • R3111x09x ~ R3111x60x

		検出電圧		٤z	ステリシス	ス幅	消	費電流 1		消	費電流 2			
製品名	-VDET[V]		V <sub>HYS</sub> [V]		Iss₁[μA]			Iss₂[μA]						
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	条件	TYP.	MAX.	条件	TYP.	MAX.		
R3111x09xx	0.882	0.900	0.918	0.027	0.045	0.063						0.9	2.7	
R3111x10xx	0.980	1.000	1.020	0.030	0.050	0.070								
R3111x11xx	1.078	1.100	1.122	0.033	0.055	0.077					1.0	2.0		
R3111x12xx	1.176	1.200	1.224	0.036	0.060	0.084								
R3111x13xx	1.274	1.300	1.326	0.039	0.065	0.091								
R3111x14xx	1.372	1.400	1.428	0.042	0.070	0.098		0.8	2.4					
R3111x15xx	1.470	1.500	1.530	0.045	0.075	0.105								1.0
R3111x16xx	1.568	1.600	1.632	0.048	0.080	0.112								
R3111x17xx	1.666	1.700	1.734	0.051	0.085	0.119								
R3111x18xx	1.764	1.800	1.836	0.054	0.090	0.126	V <sub>DD</sub> =							
R3111x19xx	1.862	1.900	1.938	0.057	0.095	0.133	(-VDET)							
R3111x20xx	1.960	2.000	2.040	0.060	0.100	0.140	-0.10V							
R3111x21xx	2.058	2.100	2.142	0.063	0.105	0.147					1.1	3.3		
R3111x22xx	2.156	2.200	2.244	0.066	0.110	0.154								
R3111x23xx	2.254	2.300	2.346	0.069	0.115	0.161								
R3111x24xx	2.352	2.400	2.448	0.072	0.120	0.168		0.0	2.7					
R3111x25xx	2.450	2.500	2.550	0.075	0.125	0.175		0.9	2.7	2.7				
R3111x26xx	2.548	2.600	2.652	0.078	0.130	0.182			ì					
R3111x27xx	2.646	2.700	2.754	0.081	0.135	0.189								
R3111x28xx	2.744	2.800	2.856	0.084	0.140	0.196								
R3111x29xx	2.842	2.900	2.958	0.087	0.145	0.203								
R3111x30xx	2.940	3.000	3.060	0.090	0.150	0.210				3.0 V <sub>DD</sub> = (-V <sub>DET</sub> ) +2.0V				
R3111x31xx	3.038	3.100	3.162	0.093	0.155	0.217								
R3111x32xx	3.136	3.200	3.264	0.096	0.160	0.224								
R3111x33xx	3.234	3.300	3.366	0.099	0.165	0.231	3.7		3.0					
R3111x34xx	3.332	3.400	3.468	0.102	0.170	0.238	V <sub>DD</sub> =	1.0			1.0	2.6		
R3111x35xx	3.430	3.500	3.570	0.105	0.175	0.245	(-V <sub>DET</sub> ) -0.13V	1.0			1.2	3.6		
R3111x36xx	3.528	3.600	3.672	0.108	0.180	0.252	-0.13 V							
R3111x37xx	3.626	3.700	3.774	0.111	0.185	0.259								
R3111x38xx	3.724	3.800	3.876	0.114	0.190	0.266			1 22					
R3111x39xx	3.822	3.900	3.978	0.117	0.195	0.273								
R3111x40xx	3.920	4.000	4.080	0.120	0.200	0.280								
R3111x41xx	4.018	4.100	4.182	0.123	0.205	0.287								
R3111x42xx	4.116	4.200	4.284	0.126	0.210	0.294								
R3111x43xx	4.214	4.300	4.386	0.129	0.215	0.301	V <sub>DD</sub> =			3.3				
R3111x44xx	4.312	4.400	4.488	0.132	0.220	0.308		1.1			1.2	2.0		
R3111x45xx	4.410	4.500	4.590	0.135	0.225	0.315	(-V <sub>DET</sub> ) -0.16V	1.1	3.3		1.3	3.9		
R3111x46xx	4.508	4.600	4.692	0.138	0.230	0.322	-0.10 V							
R3111x47xx	4.606	4.700	4.794	0.141	0.235	0.329								
R3111x48xx	4.704	4.800	4.896	0.144	0.240	0.336								
R3111x49xx	4.802	4.900	4.998	0.147	0.245	0.343			<u> </u>					
R3111x50xx	4.900	5.000	5.100	0.150	0.250	0.350								
R3111x51xx	4.998	5.100	5.202	0.153	0.255	0.357			1.2 3.6	3.6				
R3111x52xx	5.096	5.200	5.304	0.156	0.260	0.364								
R3111x53xx	5.194	5.300	5.406	0.159	0.265	0.371								
R3111x54xx	5.292	5.400	5.508	0.162	0.270	0.378	V <sub>DD</sub> =							
R3111x55xx	5.390	5.500	5.610	0.165	0.275	0.385	(-VDET)	1.2			1.4	4.2		
R3111x56xx	5.488	5.600	5.712	0.168	0.280	0.392	-0.20V							
R3111x57xx	5.586	5.700	5.814	0.171	0.285	0.399								
R3111x58xx	5.684	5.800	5.916	0.174	0.290	0.406								
R3111x59xx	5.782	5.900	6.018	0.177	0.295	0.413								
R3111x60xx	5.880	6.000	6.120	0.180	0.300	0.420								

注 1: CMOS 出力の場合: Vop に 0.7V→ (+Voet)+2.0V のパルス電圧を印加した時点から、出力電圧が 50%の電位に達するまでの時間。 Nch オープンドレイン出力の場合: 出力端子を抵抗 470kΩで 5V にプルアップし、Vop に 0.7V→ (+Voet)+2.0V のパルス電圧を 印加した時点から、出力電圧が 50%の電位に達するまでの時間。

注2: 出力電圧が 0.1V 以下になる電源電圧の値。Nch オープンドレイン品の場合は抵抗 470kΩで 5V にプルアップ。 条 件 1 : Topt=25°C 条件 2:-40°C Topt 85°C





## ■ 動作説明

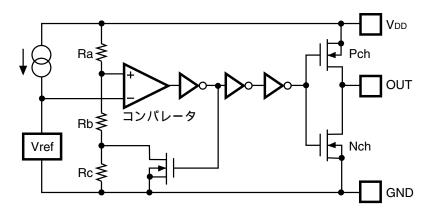
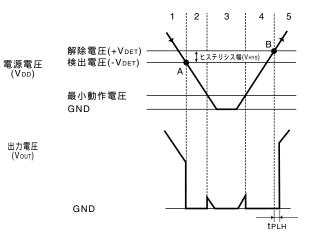


図-1 プロック図



動作状	1	2	3	4	5	
コンパレー (+)端子入:	•	I	II	III	IV	V
コンパレータ出力		Н	L	不定	L	Н
Tr.1		OFF	ON	不定	ON	OFF
出力 Tr.	Pch	ON	OFF	不定	OFF	ON
ш/J II.	Nch	OFF	ON	不定	ON	OFF

I. 
$$\frac{Rb + Rc}{Ra + Rb + Rc} \cdot V_{DD}$$

II. 
$$\frac{Rb}{Ra + Rb} \cdot V_{DD}$$

図-2 動作状態説明図

#### 動作状態の説明

出力電圧は電源電圧(VDD)と等しくなります。

A 点で Vref Vddx(Rb+Rc)/(Ra+Rb+Rc)となりコンパレータの出力が反転し、出力電圧は GND となります。A 点が検出電圧(-Vdet)です。

電源電圧が最小動作電圧より小さいときには出力トランジスタの動作は不定となり、出力がプルアップされている場合には  $V_{DD}$  が出力されます。

出力電圧は GND と等しくなります。

B 点で Vref VddxRb/(Ra+Rb)となりコンパレータの出力が反転し、出力電圧は電源電圧(Vdd)と等しくなります。B 点が解除電圧(+Vdd)です。

解除電圧と検出電圧の差がヒステリシス幅になります。

## ■ 測定回路

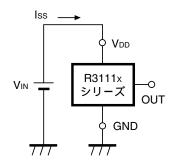


図-3 消費電流測定回路

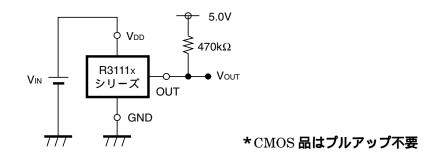


図-4 検出電圧測定回路

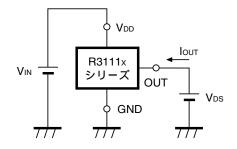


図-5 Nch ドライバ出力電流測定回路

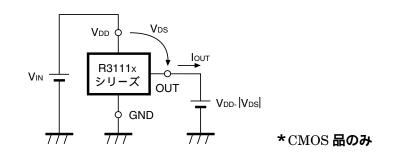


図-6 Pch ドライバ出力電流測定回路

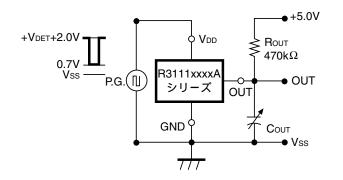


図-7 伝達遅延測定回路(1)

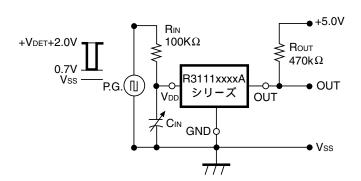
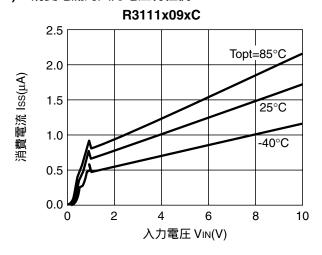
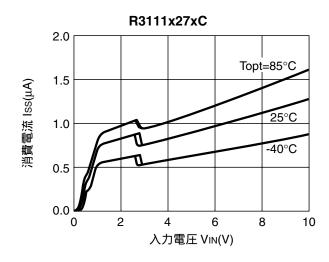


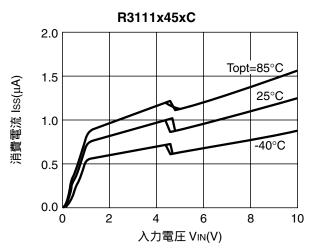
図-8 伝達遅延時間測定回路(2)

## ■ 特性例

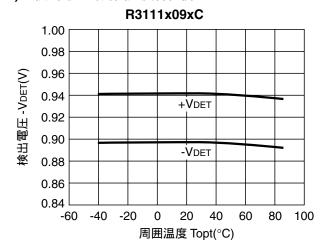
#### 1) 消費電流対入力電圧特性例

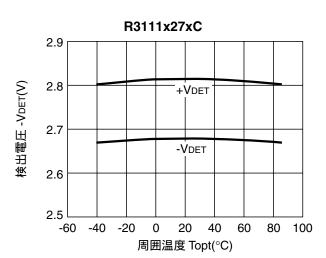


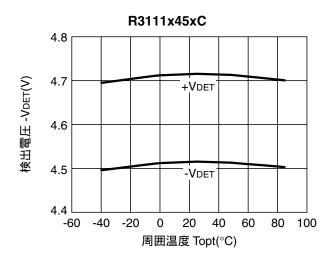




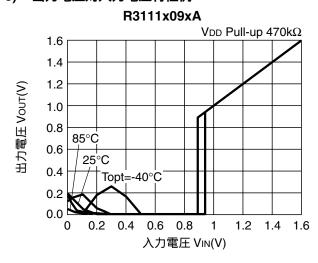
#### 2) 検出電圧対周囲温度特性例

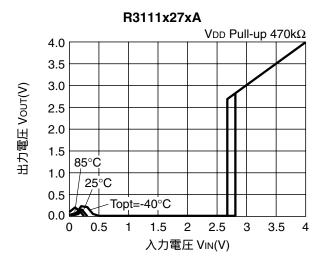


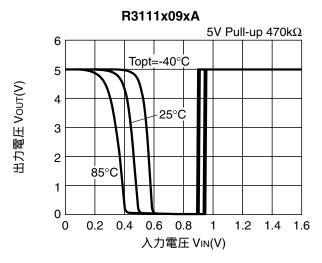


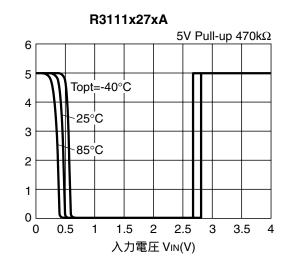


### 3) 出力電圧対入力電圧特性例

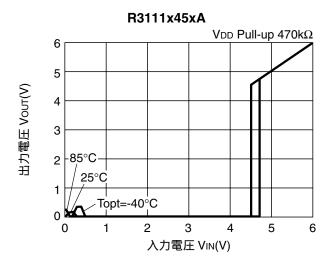


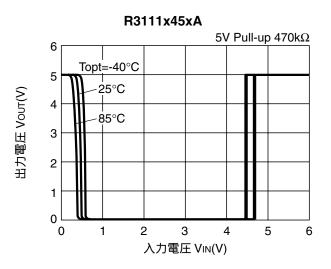




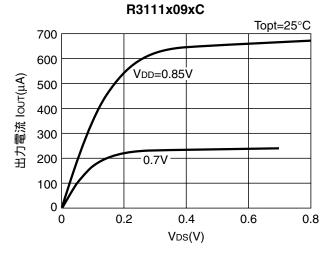


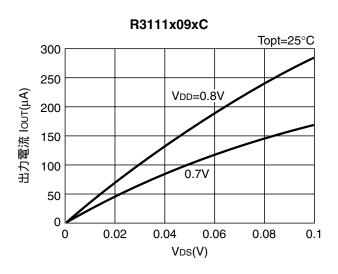
出力電圧 Vour(V)

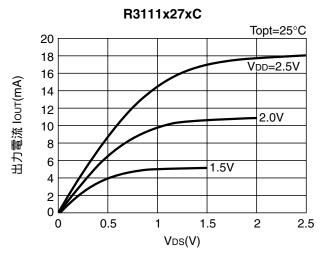


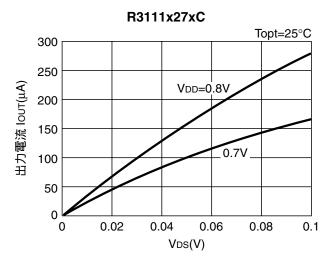


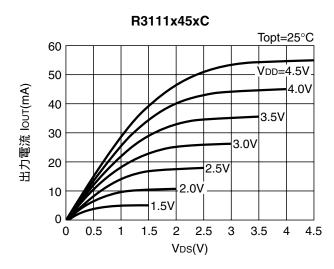
## 4) Nch ドライバ出力電流対 Vps 特性例

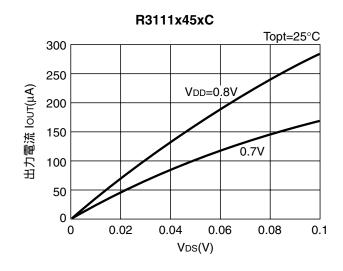




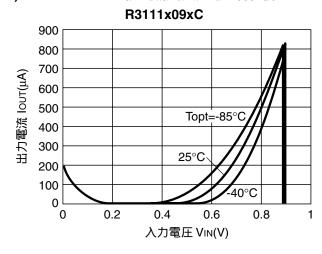


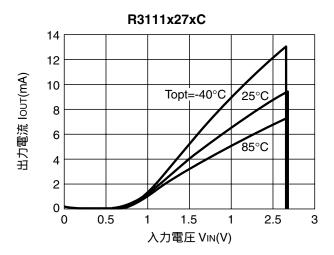


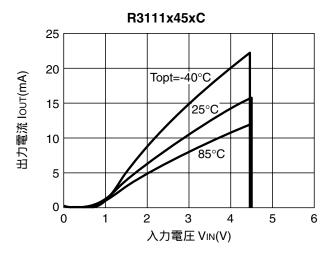




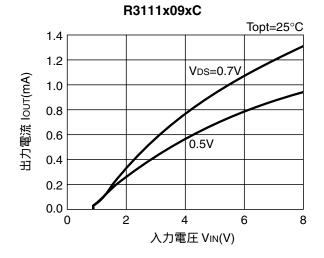
#### 5) Nch ドライバ出力電流対入力電圧特性例

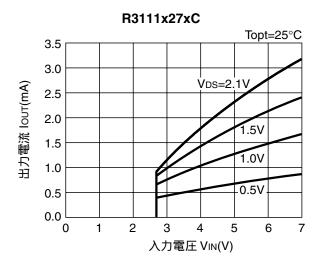


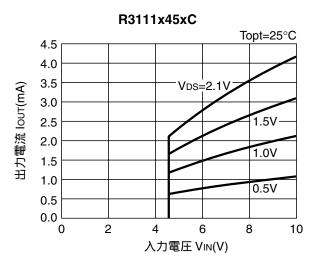




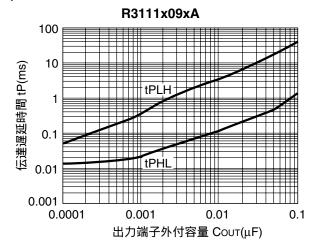
#### 6) Pch ドライバ出力電流対入力電圧特性例

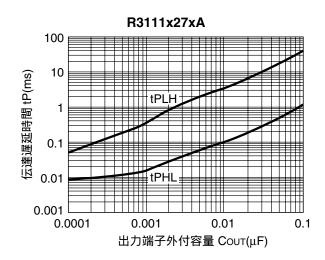


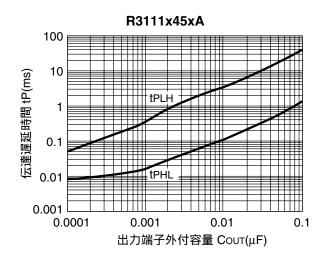




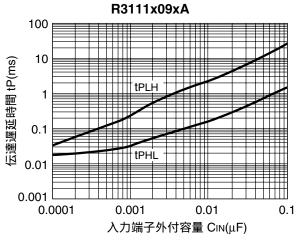
#### 7) 伝達遅延時間対出力端子外付容量特性例

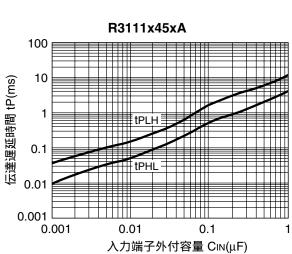


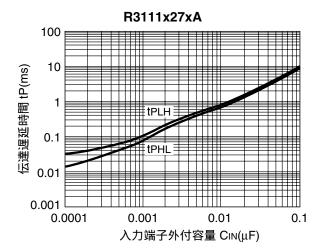




#### 8) 伝達遅延時間対入力端子外付容量特性例

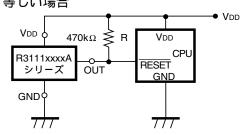




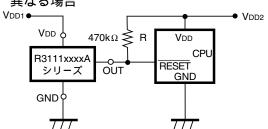


### ■ 基本回路例

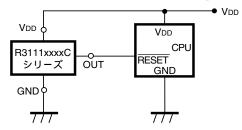
- R3111xxx1A CPU リセット回路 (Nch オープンドレイン出力)
- (1) R3111xxxxxA の入力電圧と CPU の入力電圧が 等しい場合



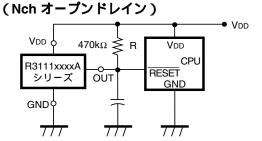
(2) R3111xxxxA の入力電圧と CPU の入力電圧が 異なる場合



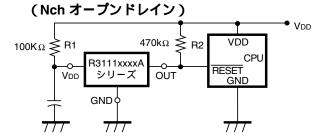
● R3111xxxxA CPU リセット回路 (CMOS 出力)



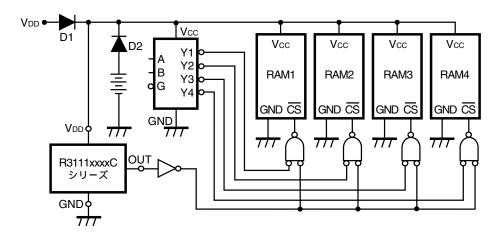
● R3111xxxxxA 伝達遅延回路 1



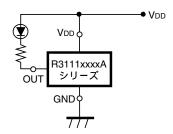
● R3111xxxxA 伝達遅延回路 2



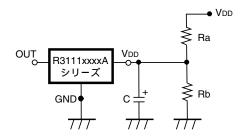
● メモリ・バックアップ回路



● 電圧レベルインジケータ回路(電圧低下時点灯タイプ) (Nch オープンドレイン出力)



● 任意電源電圧検出回路 (Nch オープンドレイン出力)

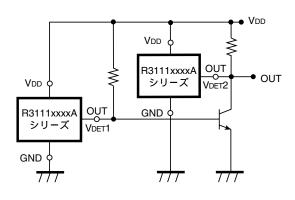


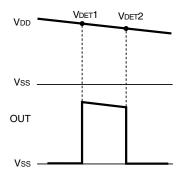
希望検出電圧=(-VDET)\*(Ra+Rb)/Rb

ヒステリシス電圧=(VHYS)\*(Ra+Rb)/Rb

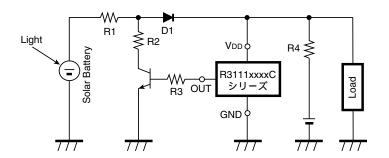
\*) Ra の値が大きくなると、IC 自体の消費電流による Ra での電圧降下のため検出電圧が計算式と異なっ てきますので注意してください。

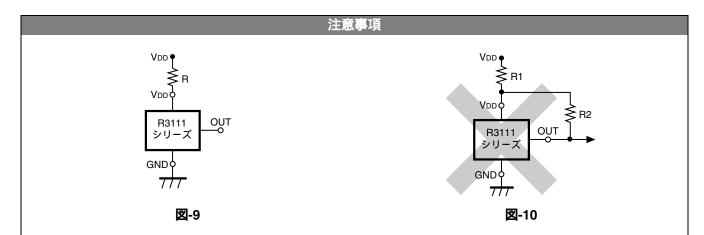
● ウィンドウコンパレータ回路 (Nch オープンドレイン)





● 過充電防止回路





- 1. 図-9 において R3111xxxxC を使用する場合、電源端子  $V_{DD}$  と R3111xxxxC シリーズの  $V_{DD}$  端子間にインピーダンスを接続すると検出時の貫通電流により発振することがありますのでご注意下さい。 R3111xxxxA を使用する場合には、R が大きくなると IC 自体の消費電流の電圧降下で検出電圧が変動してしまいますのでご注意下さい。
- 2. 図-10 のような接続は全ての出力タイプとも発振の原因になりますのでご注意下さい。